［削る］

２　三〇度超の温度で作動するように設計した前駆体容器を有するもの

３　仕事関数金属を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの

一・二　［略］

（七）～（九）　［略］

（十）　ウエハーの基板温度を五〇〇度未満に維持しながら、配線の全体又は絶縁膜と絶縁膜との隙間（幅が四〇ナノメートル未満のものに限る。）にタングステンを原子層堆積法により充填するように設計したもの

（二）に該当するものを除く。）

ソ～ナ　［略］

ラ　成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　ウエハーが設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化学反応を促進させることで成膜するものであって、シリコン及び炭素を含み、かつ、比誘電率が五・三未満の膜を、幅が七〇ナノメートル未満であり、当該幅に対する深さの比率が五倍を超え、かつ、パターンのピッチが一〇〇ナノメートル未満である水平方向の開口部に成膜するように設計したもの

二　四五度超の温度で作動するように設計した前駆体容器を有するもの

［新設］

２　仕事関数金属を成膜するよう設計した装置であって、次の全てに該当するもの

一・二　［略］

（七）～（九）　［略］

（十）　ウエハーの基板温度を五〇〇度未満に維持しながら、絶縁膜と絶縁膜との隙間（幅に対する深さの比率が五倍を超え、かつ、当該幅が四〇ナノメートル未満のものに限る。）にタングステン又はコバルトを空隙が生じないように充填するように設計した原子層堆積装置（（二）に該当するものを除く。）

ソ～ナ　［略］

ラ　四〇〇度超六五〇度未満の温度で成膜する装置又はウエハーが設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化学反応を促進させることで成膜する装置であって、次の全てに該当するシリコン及び炭素を含む膜を形成するように設計したもの

（一）　五・三未満の比誘電率のもの

（二）　四〇〇度超六五〇度未満の温度で成膜するもの（シリコン及び炭素を含み、かつ、比誘電率が五・三未満の膜を、幅が七〇ナノメートル未満であり、当該幅に対する深さの比率が五倍を超え、かつ、パターンのピッチが一〇〇ナノメートル未満である水平方向の開口部に成膜するように設計したものに限る。）であって、次の全てに該当するもの（（一）に該当するものを除く。）

１　垂直方向に積み重なった複数のウエハーを保持するように設計されたボートを有するもの

２　二以上の垂直方向に伸びるインジェクターを有するもの

３　膜のシリコン原料及びプロペンが導入されるインジェクターと膜の窒素原料又は膜の酸素原料が導入されるインジェクターが異なるもの

［削る］

ム・ウ　［略］

ヰ　厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置

ノ　［略］

オ　金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さの比率が一倍以上のものに限る。）に比誘電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置

ク　［略］

ヤ　〇・〇一パスカル以下の真空状態において、高分子残さ及び銅酸化膜を除去し、かつ、銅の成膜を可能にするように設計した洗浄除去装置

（二）　水平方向の開口部の寸法が七〇ナノメートル未満のパターンにおいて当該寸法に対する深さの比率が五倍を超えるもの

（三）　パターンのピッチが一〇〇ナノメートル未満の構造のもの

ム・ウ　［略］

ヰ　厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマにより成膜するように設計した装置

ノ　［略］

オ　金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、深さが五〇ナノメートル超のものに限る。）に比誘電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置

ク　［略］

ヤ　〇・〇一パスカル以下の真空状態において、高分子残さ及び銅酸化膜を除去し、かつ、銅の成膜を可能にするように設計した装置